

GAP500Q
GAP1000Q
GAP1500Q
GAP2000Q
GAP3000Q

InGaAs Quadrant Photodiodes

GAP Quadrant Photodiodes

Optical & Electrical Characteristics @ 23 °C ± 2 °C

Performance Specification	GAP500Q	GAP1000Q	GAP1500Q	GAP2000Q	GAP3000Q	Units
Active Surface Diameter	0.5	1	1.5	2	3	mm
Sector Area	0.0423	0.184	0.423	0.76	1.73	mm ²
Element Gap	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	mm
Crosstalk (typ max)	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	%
Wavelength Range	800 to 1700	800 to 1700	800 to 1700	800 to 1700	800 to 1700	nm
Peak Wavelength	1600	1600	1600	1600	1600	nm
Cutoff Wavelength (50%)	1650	1650	1650	1650	1650	nm
Responsivity @ λ _{PEAK} (min typ)	0.9 0.95	0.9 0.95	0.9 0.95	0.9 0.95	0.9 0.95	A/W
Dark Current @ 5 V (typ max)	0.1 2	0.6 6	1 12	2 22 @ 2V	5 50 @ 2V	nA
Shunt Resistance (min typ)	390 781	88 176	40 80	23 46	10 20	MΩ
NEP @ λ _{PEAK}	7	14	21	28	42	fW/Hz ^{1/2}
Junction Capacitance @ 0 V	4 7	19 31	41 68	72 121	165 275	pF
Junction Capacitance @ 5V	4 6	8 10	17 22	31 39 @ 2V	70 90 @ 2 V	pF
Rise/Fall Time @ 5V (typ)	0.4	1	2	4	8	ns
Package	TO46	TO46	TO46	TO5	TO5	

Maximum Ratings

Performance Specification	GAP500Q	GAP1000Q	GAP1500Q	GAP2000Q	GAP3000Q	Units
Storage Temperature	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	°C
Operating Temperature	-40 to 85	-40 to 85	-40 to 85	-40 to 85	-40 to 85	°C
Reverse Current	1	1	1	1	1	mA
Forward Current	10	10	10	10	10	mA

GPD Optoelectronics Corp.

7 Manor Parkway
Salem, NH 03079 U.S.A.



光技術をサポートする
株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング TEL:03-3356-1064
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館 TEL:06-6305-2064
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル TEL:052-569-6064

E-mail : info@optoscience.com